

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年3月3日(2005.3.3)

【公表番号】特表2002-518593(P2002-518593A)

【公表日】平成14年6月25日(2002.6.25)

【出願番号】特願2000-554901(P2000-554901)

【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 14/34

B 3 2 B 15/02

C 2 2 C 27/02

// C 2 2 F 1/00

C 2 2 F 1/18

【F I】

C 2 3 C 14/34 A

B 3 2 B 15/02

C 2 2 C 27/02

C 2 2 F 1/00 6 0 4

C 2 2 F 1/00 6 0 6

C 2 2 F 1/00 6 8 5 Z

C 2 2 F 1/00 6 9 1 C

C 2 2 F 1/00 6 9 4 A

C 2 2 F 1/18 G

【誤訳訂正書】

【提出日】平成15年3月10日(2003.3.10)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0027

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0027】

ターゲットの面にわたりそして厚みを通じて、最大結晶粒サイズが50μmであり一様な(100)結晶組織(テキスチュア; texture)を有するタンタルターゲット(純度が99.95%以上)プランクを得る本方法の1実施態様を以下に示す。

(1)摩擦なしapseット鍛造処理及びローリング処理を組み合わせることにより熱機械的処理中ビレットを加工する。

(2)apseット処理中摩擦なし鍛造処理を行い、接触面に沿った正の摩擦を発生させ処理安定性を増加する。

(3)apseット処理のパラメータを予め決定し、蓄積した歪を増加させ、プレス能力を低下させ、ローリング処理を効果的にする。

(4)ローリング条件のパラメータを予め決定し、製品の歪分布をほぼ均等にし、形状を円筒状(スパッタリングターゲットのため)にする。

(5)静的再結晶温度の最低温度をアニーリング処理温度として使用する。

(6)従来では得られない極めて微細で一様の構造及び強く一様なテキスチュアを有するスパッタリングターゲットを製造する。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】図面の簡単な説明

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 はタンタルターゲットの中央部の粒径構造の 1 0 0 X 2 5 ミクロン の顕微鏡写真を示す。

【図 2】

図 2 はタンタルターゲットの半径方向の中間部の粒径構造の 1 0 0 X 2 5 ミクロン の顕微鏡写真を示す。

【図 3】

図 3 はタンタルターゲットの縁部の粒径構造の 1 0 0 X 2 5 ミクロン の顕微鏡写真を示す。

【図 4】

図 4 は [1 0 0] キューピックテキスチュアの中央部を示す反転磁極図である。

【図 5】

図 5 は [1 0 0] キューピックテキスチュアの半径方向の中間部を示す反転磁極図である。

【図 6】

図 6 は [1 0 0] キューピックテキスチュアの縁部を示す反転磁極図である。